

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Atsushi YAMAGUCHI et al.

Application No.: 10/022,228



Filed: December 20, 2001

Docket No.: 111476

For: EXPOSURE APPARATUS AND EXPOSURE METHOD

CLAIM FOR PRIORITY

Director of the U.S. Patent and Trademark Office
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2000-390183 filed December 22, 2000

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

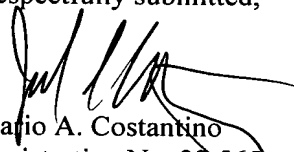
 X is filed herewith.

 was filed on in Parent Application No. filed .

 will be filed at a later date.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,


Mario A. Costantino
Registration No. 33,565

Joel S. Armstrong
Registration No. 36,430

MAC:JSA/mlb

Date: April 12, 2002

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400

**DEPOSIT ACCOUNT USE
AUTHORIZATION**
Please grant any extension
necessary for entry;
Charge any fee due to our
Deposit Account No. 15-0461



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

06809.05
前記. 西出.

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application:

2000年12月22日

出願番号
Application Number:

特願2000-390183

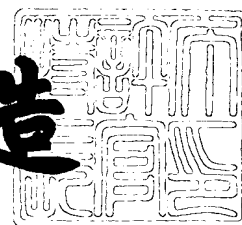
出願人
Applicant(s):

株式会社ニコン

2001年12月28日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3112874

【書類名】 特許願

【整理番号】 00-00935

【提出日】 平成12年12月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/027

【発明の名称】 露光装置及び露光方法

【請求項の数】 11

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン
内

【氏名】 山口 敦史

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン
内

【氏名】 坂本 英昭

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン
内

【氏名】 本田 泰弘

【特許出願人】

【識別番号】 000004112

【氏名又は名称】 株式会社ニコン

【代理人】

【識別番号】 100097180

【弁理士】

【氏名又は名称】 前田 均

【代理人】

【識別番号】 100099900

【弁理士】

【氏名又は名称】 西出 眞吾

【選任した代理人】

【識別番号】 100111419

【弁理士】

【氏名又は名称】 大倉 宏一郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043339

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9724186

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 露光装置及び露光方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 パターンが形成されたマスクを介して基板を露光する露光装置において、

前記マスクを保持して移動するステージと、

前記ステージの加速度を検出する加速度検出装置と、

前記加速度検出装置により検出される加速度が、予め求められた前記マスクに位置ずれが生じない前記ステージの加速度の範囲内となるように、前記ステージの移動を制御する制御装置と、

を備えたことを特徴とする露光装置。

【請求項 2】 パターンが形成されたマスクを介して基板を露光する露光装置において、

前記マスクを保持して移動するステージと、

前記ステージの加速度を検出する加速度検出装置と、

前記ステージ上の前記マスクの姿勢を検出する姿勢検出装置と、

前記加速度検出装置により検出された加速度が、予め求められた前記マスクに位置ずれが生じない前記ステージの加速度の範囲外となった場合に、前記姿勢検出装置による検出を実施し、該マスクに位置ずれが生じたと判断した場合に、その旨をオペレータに通知する処理を行う制御装置と、

を備えたことを特徴とする露光装置。

【請求項 3】 前記ステージ上の前記マスクの姿勢を調整する姿勢調整装置をさらに備え、

前記制御装置が前記マスクに位置ずれが生じたと判断した場合に、前記姿勢調整装置により該位置ずれを相殺するように該マスクの姿勢を調整することを特徴とする請求項 2 に記載の露光装置。

【請求項 4】 前記加速度の範囲は、前記ステージの加速度を段階的に増大又は減少させつつ、前記マスクの位置ずれの検出を繰り返し行うことにより試行錯誤的に導出することを特徴とする請求項 1, 2 又は 3 に記載の露光装置。

【請求項5】 前記加速度の範囲の導出は、前記露光装置の起動時及び前記マスクの交換時の少なくとも一方において実施することを特徴とする請求項4に記載の露光装置。

【請求項6】 前記ステージの前記加速度の範囲が記憶される記憶装置をさらに備えたことを特徴とする請求項1～5のいずれか一項に記載の露光装置。

【請求項7】 前記ステージによる前記マスクの吸着能力に関する情報を検出するセンサを更に備え、

前記制御装置は、前記検出された情報に従って前記加速度の範囲を変更することを特徴とする請求項1～6のいずれか一項に記載の露光装置。

【請求項8】 パターンが形成されたマスクを介して基板を露光する露光方法において、

前記マスク又は前記基板を保持して移動するステージの加減速によって該マスク又は該基板に位置ずれが生じない該ステージの加速度の範囲を予め求めておき、

前記加速度の範囲内で前記ステージの移動を制御しながら露光することを特徴とする露光方法。

【請求項9】 パターンが形成されたマスクを介して基板を露光する露光方法において、

前記マスク又は前記基板を保持して移動するステージの加減速によって該マスク又は該基板に位置ずれが生じない該ステージの加速度の範囲を予め求めておき、

前記ステージの加速度を検出して該ステージの加速度が前記加速度の範囲外となった場合に前記マスク又は前記基板の位置ずれの有無を検出し、

前記マスク又は前記基板に位置ずれが生じていると判断した場合に、該位置ずれを相殺するように該マスク又は該基板の姿勢を調整することを特徴とする露光方法。

【請求項10】 前記マスク又は前記基板に位置ずれが生じていると判断した場合に、その旨をオペレータに通知する処理を行うことを特徴とする請求項9に記載の露光方法。

【請求項 11】 前記ステージによる前記マスクの吸着能力に関する情報を検出し、

前記検出された情報に従って前記加速度の範囲を変更することを特徴とする請求項 8～10 のいずれか一項に記載の露光方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体集積回路、液晶表示素子、撮像素子、薄膜磁気ヘッド、その他のデバイス等の製造に用いられる露光装置及び露光方法に関し、特にマスクと基板とを同期走査させつつ、マスクに形成されたパターンの像を基板に露光する露光装置及び露光方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

半導体集積回路、液晶表示素子、撮像素子、薄膜磁気ヘッド、その他のデバイス等の製造においては、露光装置を用いてフォトマスクやレチクル（以下、これらを総称する場合にはマスクと称する）に形成された微細なパターンの像を投影光学系を介してフォトレジスト等の感光剤が塗布された半導体ウエハやガラスプレート等の基板上に転写することが繰り返し行われる。

【0003】

半導体集積回路の製造においては、基板を二次元的に移動自在な基板ステージ上に載置し、この基板ステージにより基板を歩進（ステッピング）させて、レチクルのパターンの像を基板上の各ショット領域に順次露光転写する動作を繰り返す、ステップ・アンド・リピート方式の縮小投影型の露光装置（いわゆるステッパー）が使用されている。

【0004】

また、近年においては、基板の面積化及びパターンの微細化に伴い、基板を載置した基板ステージと、露光すべきパターンが形成されたレチクルを載置したレチクルステージとを互いに同期移動させつつ、レチクルに形成されたパターンの像を基板に転写するステップ・アンド・スキャン方式の露光装置が用いられる

ようになってきた。

【 0 0 0 5 】

ステップ・アンド・スキャン方式の露光装置を用いて露光処理を行う場合であっても、ステッパーと同様に、既にパターンが形成された基板上にフォトリジスト等の感光剤を塗布して、異なるパターンを露光することが繰り返し行われる。よって、基板と投影されるレチクルに形成されたパターンとの相対位置を高い精度をもって計測し、更に、露光時における基板とレチクルとの相対位置を精密に合わせる必要がある。特に、ステップ・アンド・スキャン方式の露光装置においては、露光開始時点におけるレチクルと基板との相対位置及び走査速度を正確に制御する必要がある。

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、デバイスの製造においては、製造コストの低減等を図るため、露光装置で単位時間に処理することのできる基板の枚数（スループット）を向上させることが要求される。上述したステップ・アンド・スキャン方式の露光装置は、レチクルと基板とを同期走査させて露光を行っているが、スループット向上のためには、露光時におけるレチクルステージと基板ステージとの走査速度を向上させる必要がある。

【 0 0 0 7 】

ステップ・アンド・スキャン方式の露光装置は、露光時には、レチクルステージと基板ステージとを一定の速度で移動するため、走査開始時点においては静止した状態から一定の走査速度までレチクルステージ及び基板ステージを加速させなければならない。走査終了時点においては一定の走査速度で移動しているレチクルステージ及び基板ステージを減速して静止させなければならない。スループット向上のためには、レチクルステージ及び基板ステージの走査速度を高くする必要があるが、この走査速度が高くとるとレチクルステージの加減速時における加速度の値も高くする必要がある。

【 0 0 0 8 】

ステージが移動すると基板やレチクル等の載置物の位置がずれることが考えら

れるが、これを防止するためにステップ・アンド・スキャン方式の露光装置では、レチクルはレチクルステージ上に負圧吸着された状態で保持され、基板は基板ステージ上に負圧吸着された状態で保持される。よって、レチクル又は基板に加速又は減速により走査方向又はその反対方向にある程度の力が加わっても、レチクルステージ上におけるレチクルの位置又は基板ステージ上における基板の位置がずれることはない。

【0009】

しかしながら、レチクルステージ又は基板ステージの加速時及び減速時における加速度の値を高くすると、レチクル及び基板を吸着保持していてもその位置がずれる可能性がある。基板はほぼ底面の全面が基板ステージに真空吸着されるため吸着力を比較的高くすることができるが、レチクルはパターンに形成された像を透過させる必要があるため、レチクルの底面の周辺部のみを吸着することしかできない。

【0010】

また、投影倍率が $1/\beta$ (β は例えば4、5、6等)である縮小投影型の投影光学系を備える場合には、レチクルステージの走査速度を基板ステージの走査速度の β 倍に設定しなければならない。よって、その分レチクルステージの加減速時の加速度を基板ステージのそれよりも高く設定しなければならない。以上から、走査速度を高くすると、レチクルの位置ずれが生ずる可能性が高くなる。レチクルの位置ずれが生ずると、レチクルと基板との相対位置がずれた状態でレチクルに形成されたパターンの像が基板に転写されるため、製造されるデバイスが所期の性能を発揮しない不良品になるおそれがある。特に、微細なパターンが形成されるデバイスを製造する際には、僅かな位置ずれで不良品となることが考えられる。

【0011】

さらに、基板の露光時以外、例えばレチクルのアライメント時、あるいはアライメント位置から露光位置(加速開始位置)にレチクルを移動する場合などでも、レチクルステージの加速度が高いと、前述と同様にレチクルの位置ずれが発生して基板とのアライメント精度などが低下するという問題がある。

【 0 0 1 2 】

本発明はこのような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、マスクの移動に伴う位置ずれを生じさせずに高スループットで露光できるようにすることを目的とする。また、仮にマスクの移動に伴う位置ずれが生じた場合には、位置ずれのある状態で露光処理が進行することを防止できるようにすることも目的とする。

【 0 0 1 3 】

【課題を解決するための手段】

以下、この項に示す例では、理解の容易化のため、本発明の各構成要件に実施形態の図に示す代表的な参照符号を付して説明するが、本発明の構成又は各構成要件は、これら参照符号によって拘束されるものに限定されない。

【 0 0 1 4 】

上記課題を解決するために、本発明の第 1 の観点によると、パターンが形成されたマスク (R) を介して基板 (W) を露光する露光装置 (35) において、前記マスク (R) を保持して移動するステージ (11) と、前記ステージ (11) の加速度を検出する加速度検出装置 (17) と、前記加速度検出装置 (17) により検出される加速度が、予め求められた前記マスク (R) に位置ずれが生じない前記ステージ (11) の加速度の範囲内となるように、前記ステージ (11) の移動を制御する制御装置 (30) とを備えたことを特徴とする露光装置が提供される。

【 0 0 1 5 】

この発明によれば、制御装置がマスクを保持して移動するステージの移動を制御する際に、加速度検出装置により検出される加速度がマスクに位置ずれが生じないステージの加速度の範囲内となるように、ステージの移動を制御しているので、露光を行うときにマスクの位置ずれを生じさせることはない。また、マスクに位置ずれを生じさせない範囲内で、より高い加速度でステージを移動させることにより、マスクステージの移動に伴う位置ずれを生じさせずに高スループットで露光を行うことができる。

【 0 0 1 6 】

上記課題を解決するために、本発明の第2の観点によると、パターンが形成されたマスク（R）を介して基板（W）を露光する露光装置（35）において、前記マスク（R）を保持して移動するステージ（11）と、前記ステージ（11）の加速度を検出する加速度検出装置（17）と、前記ステージ（11）上の前記マスク（R）の姿勢を検出する姿勢検出装置（43A、43B）と、前記加速度検出装置（17）により検出された加速度が、予め求められた前記マスク（R）に位置ずれが生じない前記ステージ（11）の加速度の範囲外となった場合に、前記姿勢検出装置（43A、43B）による検出を実施し、該マスク（R）に位置ずれが生じたと判断した場合に、その旨をオペレータに通知する処理を行う制御装置（30）とを備えたことを特徴とする露光装置が提供される。

【0017】

この発明によれば、加速度検出装置により検出された加速度がマスクに位置ずれが生じない加速度の範囲外となったときに、姿勢検出装置を用いてマスクの姿勢を検出し、姿勢検出装置の検出結果によりマスクの位置ずれが検出された場合には、その旨がオペレータに通知されるため、マスクの位置ずれが生じたまま露光処理が進行して不良品を生じさせるおそれがない。

【0018】

また、マスクの位置ずれが生ずる加速度の範囲は、マスクの位置ずれが生じない加速度の範囲と明確に区分されているわけではなく、例えば、温度や湿度等の周囲の状況に応じて加速度が同じであってもマスクの位置ずれが生じたり生じなかったりする加速度の範囲がある。高スループットを実現するために位置ずれが全く生じない範囲でステージの移動を行うのではなく、マスクが移動する可能性があってもステージの加速度を高めたいという要求もあると考えられる。本発明を適用することにより、かかる要求にも応えることができる。仮に、加速度を高く設定し過ぎてマスクの位置ずれが生じた場合であっても、位置ずれが生じたまま露光処理が進行することを防止できる。

【0019】

上記第2の観点による露光装置において、前記ステージ（11）上の前記マスク（R）の姿勢を調整する姿勢調整装置（18）をさらに設け、前記制御装置（

30) が前記マスク (R) に位置ずれが生じたと判断した場合に、前記姿勢調整装置 (18) により該位置ずれを相殺するように該マスク (R) の姿勢を調整するようにできる。マスクに位置ずれが生じたと判断したときに、制御装置が姿勢調整装置により位置ずれを相殺するようにマスクの姿勢を調整しているので、マスクの位置ずれが生じても自動的にそのずれが修正されるため、高スループットを図る上で好ましい。

【0020】

上記第1の観点及び第2の観点による露光装置において、前記加速度の範囲を、前記ステージ (11) の加速度を段階的に増大又は減少させつつ、前記マスク (R) の位置ずれの検出を繰り返し行うことにより試行錯誤的に導出するようにできる。

【0021】

上記第1の観点及び第2の観点による露光装置において、前記加速度の範囲の導出を、前記露光装置 (35) の起動時及び前記マスク (R) の交換時の少なくとも一方において実施するようにできる。

【0022】

上記第1の観点及び第2の観点による露光装置において、前記ステージ (11) の前記加速度の範囲が記憶される記憶装置をさらに設けることができる。

【0023】

上記第1の観点及び第2の観点による露光装置において、前記ステージ (11) による前記マスクの吸着能力に関する情報を検出するセンサをさらに設け、前記制御装置 (30) により、前記出された情報に従って前記加速度の範囲を変更するようにしてもよい。この場合のセンサとしては、吸着能力 (真空圧力) を測定する真空センサなどを採用することができる。

【0024】

上記課題を解決するために、本発明の第3の観点によると、パターンが形成されたマスク (R) を介して基板 (W) を露光する露光方法において、前記マスク (R) 又は前記基板 (W) を保持して移動するステージ (11) の加減速によって該マスク (R) 又は該基板 (W) に位置ずれが生じない該ステージ (11) の

加速度の範囲を予め求めておき、前記加速度の範囲内で前記ステージ（１１）の移動を制御しながら露光することを特徴とする露光方法が提供される。

【 0 0 2 5 】

この発明によれば、上記第１の観点による露光装置と同様に、露光を行うときにマスク又は基板の位置ずれを生じさせずに高スループットで露光を行うことができる。

【 0 0 2 6 】

上記課題を解決するために、本発明の第４の観点によると、パターンが形成されたマスク（Ｒ）を介して基板（Ｗ）を露光する露光方法において、前記マスク（Ｒ）又は前記基板（Ｗ）を保持して移動するステージ（１１）の加減速によって該マスク（Ｒ）又は該基板（Ｗ）に位置ずれが生じない該ステージ（１１）の加速度の範囲を予め求めておき、前記ステージ（１１）の加速度を検出して該ステージ（１１）の加速度が前記加速度の範囲外となった場合に前記マスク（Ｒ）又は前記基板（Ｗ）の位置ずれの有無を検出し、前記マスク（Ｒ）又は前記基板（Ｗ）に位置ずれが生じていると判断した場合に、該位置ずれを相殺するように該マスク（Ｒ）又は該基板（Ｗ）の姿勢を調整することを特徴とする露光方法が提供される。

【 0 0 2 7 】

この発明によれば、上記第２の観点による露光装置と同様に、マスク又は基板に位置ずれが生じたと判断したときに、該位置ずれを相殺するようにマスク又は基板の姿勢を調整しているので、マスク又は基板の位置ずれが生じても自動的にそのずれが修正されるため高スループットを図る上で好ましい。

【 0 0 2 8 】

本発明の第４の観点による露光方法において、前記マスク（Ｒ）又は前記基板（Ｗ）に位置ずれが生じていると判断した場合に、その旨をオペレータに通知する処理を行うようにできる。加速度検出装置により検出された加速度がマスク又は基板に位置ずれが生じない加速度の範囲外となったときに、マスク又は基板の姿勢を検出し、該マスク又は該基板の位置ずれが検出された場合には、その旨がオペレータに通知されるため、マスク又は基板の位置ずれが生じたまま露光処理

が進行して不良品を生じさせるおそれがない。

【0029】

上記第3の観点及び第4の観点による露光方法において、前記ステージ（11）による前記マスクの吸着能力に関する情報を検出し、当該検出された情報に従って前記加速度の範囲を変更するようにしてもよい。

【0030】

なお、本発明で「マスク又は基板に位置ずれが生じない」とは、その位置ずれ量が完全に零である場合だけでなく、実質的に零とみなせる場合、例えばデバイス製造工程で精度上無視できる所定量以下である場合なども含まれる。

【0031】

また、「位置ずれが生じないステージの加速度」とは、その上限値または範囲などがステージによるマスクまたは基板の保持力（吸着力）に応じて異なるものであり、例えば環境または経時的な要因などによって吸着力が変動する、あるいはその吸着力を可変とするステージでは加速度の上限値またはその範囲も変化することになる。従って、加速度の上限値またはその範囲は、ステージの吸着力の最大値に対応して定めてもよいが、実際の吸着能力に対応して定めることが望ましい。さらに、「加速度検出装置」は加速度計、振動センサ、あるいはステージの位置情報を検出するレーザ干渉計など、加速度を直接または間接に計測する装置に限られるものではなく、例えばステージを駆動する駆動系に駆動指令を与える制御系など、加速度に関連する情報を格納または生成する装置などを含むものである。このとき、加速度そのものでなく速度など、他の関連情報を検出してもよい。

【0032】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図1は、本発明の実施形態に係る露光装置の全体構成を示す図である。なお、以下の説明においては、図1中に示されたXYZ直交座標系を設定し、このXYZ直交座標系を参照しつつ各部材の位置関係について説明する。XYZ直交座標系は、Y軸及びZ軸が紙面に対して平行となるよう設定され、X軸が紙面に対して垂直となる方向に

設定されている。図中のXYZ座標系は、実際にはXY平面が水平面に平行な面に設定され、Z軸が鉛直上方向に設定される。

【0033】

図1に示すように、本実施形態の露光装置35は、ステップ・アンド・スキャン方式の露光装置であり、レチクルR（マスク）上のパターンの一部を投影光学系PLを介してレジストが塗布されたウエハW（基板）上に縮小投影した状態で、レチクルRとウエハWとを、投影光学系PLに対して同期走査させることにより、レチクルR上のパターンの縮小像を逐次ウエハWの各ショット領域に転写するようになっている。

【0034】

この露光装置35は、照明光源1としてKrFエキシマレーザ（発振波長248nm）を備えている。照明光源1としては、特に限定されず、g線（436nm）、i線（365nm）、ArFエキシマレーザ（193nm）、F₂レーザ（157nm）、Ar₂エキシマレーザ（波長126nm）等を採用することができる。露光光源1からパルス発光されたレーザビームLBは、ビーム整形・変調光学系2へ入射する。本実施形態では、ビーム整形・変調光学系2は、ビーム整形光学系2aと、エネルギー変調器2bとから構成されている。ビーム整形光学系2aは、シリンダレンズやビームエキスパンダ等で構成され、これらにより、後続のフライアイレンズ5に効率よく入射するようにビームの断面形状が整形される。

【0035】

エネルギー変調器2bは、エネルギー粗調器及びエネルギー微調器等から構成されている。エネルギー粗調器は、回転自在なレボルバ上に透過率（＝（1－減光率）×100（％））の異なる複数個のNDフィルタを配置したものであり、そのレボルバを回転することにより、入射するレーザビームLBに対する透過率を100％から複数段階で切り換えることができるようになっている。なお、そのレボルバと同様のレボルバを2段配置し、2組のNDフィルタの組み合わせによってより細かく透過率を調整できるようにしてもよい。一方、エネルギー微調器は、ダブル・グレーティング方式又は傾斜角可変の2枚の平行平板ガラスを組

み合わせた方式等で、所定範囲内でレーザビームLBに対する透過率を連続的に微調整するものである。但し、このエネルギー微調器を使用する代わりに、露光光源1の出力変調によってレーザビームLBのエネルギーを微調整してもよい。

【0036】

ビーム整形・変調光学系2から射出されたレーザビームLBは、光路折り曲げ用のミラーMを介してフライアイレンズ5に入射する。フライアイレンズ5は、後続のレチクルRを均一な照度分布で照明するために多数の2次光源を形成する。なお、オプティカルインテグレータ（ホモジナイザー）としてのフライアイレンズ5を用いる代わりに、ロッドインテグレータ（内面反射型インテグレータ）あるいは回折光学素子等を採用することができる。

【0037】

フライアイレンズ5の射出面には照明系の開口絞り（いわゆる σ 絞り）6が配置されており、その開口絞り6内の2次光源から射出されるレーザビーム（以下、「パルス照明光IL」と呼ぶ）は、反射率が低く透過率の高いビームスプリッタ7に入射し、ビームスプリッタ7を透過したパルス照明光ILは、リレーレンズ8を介してコンデンサレンズ10へ入射する。

【0038】

リレーレンズ8は、第1リレーレンズ8Aと、第2リレーレンズ8Bと、これらレンズ8A、8B間に配置される固定照明視野絞り（固定レチクルブラインド）9A及び可動照明視野絞り9Bとを有する。固定照明視野絞り9Aは、矩形の開口部を有し、ビームスプリッタ7を透過したパルス照明光ILは、第1リレーレンズ8Aを経て固定照明視野絞り9Aの矩形の開口部を通過するようになっている。また、この固定照明視野絞り9Aは、レチクルRのパターン面に対する共役面の近傍に配置されている。可動照明視野絞り9Bは、走査方向の位置及び幅が可変の開口部を有し、固定照明視野絞り9Aの近傍に配置されている。走査露光の開始時及び終了時にその可動照明視野絞り9Bを介して照明視野フィールドを更に制限することによって、不要な部分（レチクルに形成されたパターンの像が転写されるウエハW上のショット領域以外）の露光が防止されるようになっている。

【 0 0 3 9 】

固定照明視野絞り 9 A 及び可動照明視野絞り 9 B を通過したパルス照明光 I L は、第 2 リレーレンズ 8 B 及びコンデンサレンズ 1 0 を経て、ステージとしてのレチクルステージ 1 1 上に真空吸着保持されたレチクル R 上の矩形の照明領域 R 1 を均一な照度分布で照明する。レチクル R 上の照明領域 R 1 内のパターンを投影光学系 P L を介して投影倍率 β (β は例えば $1/4$, $1/5$ 等) で縮小した像が、フォトリソが塗布されたウエハ W 上の照明視野フィールド W 1 に投影露光される。このとき、レチクルステージ 1 1 は姿勢調整装置としてのレチクルステージ駆動部 1 8 により + Y 軸方向に走査される。レチクルステージ 1 1 は、X Y 平面内において微小回転可能に構成され、その回転角はレチクルステージ駆動部 1 8 により調整される。

【 0 0 4 0 】

レチクルステージ 1 1 の一端には移動鏡 1 3 が取り付けられており、移動鏡 1 3 の鏡面側に配置されたレーザ干渉計 1 6 によりレチクルステージ 1 1 の X 軸方向及び Y 軸方向の座標並びに X Y 平面内における回転量がステージコントローラ 1 7 に供給され、ステージコントローラ 1 7 は後述する主制御系 3 0 の制御の下、供給された座標及び回転量に基づいて姿勢調整装置としてのレチクルステージ駆動部 1 8 を介して、レチクルステージ 1 1 の位置及び速度を制御する。また、ステージコントローラ 1 7 は、レーザ干渉計 1 6 から出力される検出信号に基づいてレチクルステージ 1 1 の加速度を検出する。ここで、ステージコントローラ 1 7 は、本発明にいう加速度検出装置をなすものである。

【 0 0 4 1 】

一方、ウエハ W は、不図示のウエハホルダを介してウエハステージ 2 1 上に真空吸着により保持される。ウエハステージ 2 1 は、Z チルトステージ 1 9 と、Z チルトステージ 1 9 が載置される X Y ステージ 2 0 とを有する。X Y ステージ 2 0 は、X 軸方向及び Y 軸方向にウエハ W の位置決めを行うとともに、- Y 軸方向にウエハ W を移動する。Z チルトステージ 1 9 は、ウエハ W の Z 軸方向の位置（フォーカス位置）を調整するとともに、X Y 平面に対するウエハ W の傾斜角を調整する機能を有する。また、Z チルトステージ 1 9 上の一端には移動鏡 1 4 が固

定され、移動鏡 1 4 の鏡面側に配置されたレーザ干渉計 2 2 により X Y ステージ 2 0 (ウエハ W) の X 座標及び Y 座標並びに X Y 面内における回転量が計測される。これらの計測値は、ステージコントローラ 1 7 に供給され、ステージコントローラ 1 7 は、供給された座標及び回転量に基づいてウエハステージ駆動部 2 3 を介して X Y ステージ 2 0 の位置及び速度を制御する。また、ステージコントローラ 1 7 は、レーザ干渉計 2 2 から出力される検出信号に基づいて X Y ステージ 2 0 の加速度を検出する。

【 0 0 4 2 】

ステージコントローラ 1 7 は、装置全体を統轄制御する主制御装置としての主制御系 3 0 によって制御されている。そして、走査露光時には、レチクル R がレチクルステージ 1 1 を介して + Y 軸方向 (又は - Y 軸方向) に速度 V_R で走査されるのに同期して、X Y ステージ 2 0 を介してウエハ W は照明視野フィールド W 1 に対して - Y 軸方向 (又は + Y 軸方向) に速度 $\beta \cdot V_R$ (β はレチクル R からウエハ W に対する投影倍率) で走査される。また、制御装置 3 0 は、走査露光前にレチクルステージ 1 1 の速度が速度 V_R となるようにレチクルステージ 1 1 を加速させる必要があるが、このときレチクルステージ 1 1 上に載置されたレチクル R に位置ずれが生じない範囲でレチクルステージ 1 1 の移動を制御する。また、走査露光後においても、レチクルステージ 1 1 を静止させる必要があるが、このときもレチクルステージ 1 1 上に載置されたレチクル R に位置ずれが生じない範囲でレチクルステージ 1 1 の移動を制御する。

【 0 0 4 3 】

記憶装置 3 1 は、レチクルステージ 1 1 を移動させたときにレチクル R の位置ずれが生じない加速度の範囲を記憶する。この加速度の範囲は、計算 (シミュレーション) にて求めてもよいが、本例では実際にレチクル R をレチクルステージ 1 1 上に載置した状態でレチクルステージ 1 1 の加速度を段階的に変えて移動させることにより試行錯誤的に求めて記憶装置 3 1 に記憶させている。なお、記憶装置 3 1 に記憶させる加速度の範囲は、上記位置ずれが生じない加速度の範囲、位置ずれが生ずる可能性のある加速度の範囲、及び必ず位置ずれが生ずる加速度の範囲を記憶装置 3 1 に記憶させておくことが好ましい。なお、以上の加速度の

範囲の求め方の詳細については後述する。

【 0 0 4 4 】

ここで、「位置ずれが生じない」とは、レチクル R が全く位置ずれしないことのみを意味するのではなく、実際には微小な位置ずれが生じているけれども実質的に位置ずれが生じていないとみなせる範囲、例えば、その状態で露光処理を実施した場合に、パターンの重ね合わせ精度などが許容範囲内となるような位置ずれの範囲が含まれる。これに対し、「位置ずれが生ずる」とは、実際には微小な位置ずれが生じているけれども実質的に位置ずれが生じていないとみなせる範囲、例えば、その状態で露光処理を実施した場合に、パターンの重ね合わせ精度などが許容範囲内となるような位置ずれの範囲は含まない。

【 0 0 4 5 】

また、Zチルトステージ 1 9 上のウェハ W の近傍には光電変換素子からなる照度むらセンサ 1 5 が常設され、照度むらセンサ 1 5 の受光面はウェハ W の表面と同じ高さに設定されている。照度むらセンサ 1 5 としては、遠紫外で感度があり、且つパルス照明光 I L を検出するために高い応答周波数を有する P I N 型のフォトダイオード等が使用できる。照度むらセンサ 1 5 の検出信号が不図示のピークホールド回路、及びアナログ／デジタル (A/D) 変換器を介して露光コントローラ 2 6 に供給されている。

【 0 0 4 6 】

なお、ビームスプリッタ 7 で反射されたパルス照明光 I L は、集光レンズ 2 4 を介して光電変換素子よりなるインテグレータセンサ 2 5 で受光され、インテグレータセンサ 2 5 の光電変換信号が、不図示のピークホールド回路及び A/D 変換器を介して出力 D S として露光コントローラ 2 6 に供給される。インテグレータセンサ 2 5 の出力 D S と、ウェハ W の表面上でのパルス照明光 I L の照度（露光量）との相関係数は予め求められて露光コントローラ 2 6 内に記憶されている。露光コントローラ 2 6 は、制御情報 T S を照明光源 1 に供給することによって、照明光源 1 の発光タイミング及び発光パワー等を制御する。露光コントローラ 2 6 は、更にエネルギー変調器 2 b での減光率を制御し、ステージコントローラ 1 7 はステージ系の動作情報に同期して可動照明視野絞り 9 B の開閉動作を制御

する。

【 0 0 4 7 】

次に、本発明の実施形態に係る露光装置が備えるアライメント系（アライメント装置）について、図 2 を参照して説明する。ウエハステージ 2 1 の上方において、投影光学系 P L にはオフアクシス（O f f - A x i s）方式のウエハアライメント顕微鏡 4 2 が固定されている。一方、レチクル R の上方には、T T R（T h r o u g h T h e R e t i c l e）方式の一对のレチクルアライメント顕微鏡 4 3 A，4 3 B が配置されている。ウエハステージ 2 1 には、レチクルアライメント顕微鏡 4 3 A，4 3 B 用の基準マーク（フィジューシャル・マーク）F M A，F M B 及びウエハアライメント顕微鏡 4 2 用の基準マーク 4 1 が形成された基準マーク板 4 0 が固定されている。

【 0 0 4 8 】

ウエハアライメント顕微鏡 4 2 は、ウエハ W 上に形成されたウエハ・アライメント・マーク（以下、ウエハマークという）W M や、基準マーク板 4 0 に形成された基準マーク 4 1 の位置を計測することができる。なお、図示は省略しているが、ウエハアライメント顕微鏡 4 2 の内部には、マークを計測する際の基準となる指標が設けられている。また、レチクル R のパターンが形成された領域（パターン領域）の外側には、レチクルアライメント顕微鏡 4 3 A，4 3 B によって観察可能な一对のレチクル・アライメント・マーク（以下、レチクルマークという）R M A，R M B が形成されている。これらとウエハステージ 2 1 上の基準マーク板 4 0 に形成されている一对の基準マーク F M A，F M B とを同時に観察することで、レチクル R のレチクルマーク R M A，R M B と、ウエハステージ 2 1 上の基準マーク F M A，F M B との位置合わせを行うことができる。

【 0 0 4 9 】

ウエハステージ 2 1 上の基準マーク板 4 0 に形成されたレチクルアライメント顕微鏡用の基準マーク F M A，F M B と、ウエハアライメント顕微鏡用の基準マーク 4 1 との位置関係は、予め正確に計測されて、記憶保持されている。レチクルアライメント顕微鏡 4 3 A とレチクルアライメント顕微鏡 4 3 B の構成は同一の構成である。これらレチクルアライメント顕微鏡 4 3 A，4 3 B は本発明にい

う姿勢検出装置に相当するものであり、上述したレチクルマーク RMA, RMB とウエハステージ 2 1 上の基準マーク FMA, FMB との位置合わせを行う以外に、レチクルステージ 1 1 を加速又は減速させたときに生ずるレチクル R の X 軸方向の位置ずれ、Y 軸方向の位置ずれ、及び X Y 面内におけるレチクル R の回転量を含めたレチクル R の姿勢を検出する目的で用いられる。

【 0 0 5 0 】

図 3 は、レチクルアライメント顕微鏡 4 3 A, 4 3 B で検出されるレチクルマーク及び基準マークの像並びにその光電変換信号を示す図である。これらレチクルマーク RMA や基準マーク FMA の具体的な形状は、特に限定されないが、同図に示すように、2 次元方向に位置ずれ量を検知することができるようなマークの組み合わせであることが好ましい。図 3 (a) には、矩形状のレチクルマーク RMA が、四方に配置されたストライプ状の基準マーク FMA の内側に配置される例が示されている。また、図 3 (b) には、相互に垂直なストライプが十字形に形成してある基準マーク FMA が内側に配置されており、その外側にストライプ状のレチクルマーク RMA が四方に配置されている。レチクルマーク RMB はレチクルマーク RMA と同一であり、基準マーク FMB は基準マーク FMA と同一の形状である。

【 0 0 5 1 】

このように、一对のレチクルアライメント顕微鏡 4 3 A, 4 3 B がレチクルマーク RMA の像と基準マーク FMA の像、レチクルマーク RMB の像と基準マーク FMB の像とをそれぞれ同時に観測して、図 3 (a) , (b) に示すように、二次元方向に光電変換信号を検出して、主制御系 3 0 に供給し、主制御系 3 0 が、レチクルマーク RMA と基準マーク FMA との位置ずれ及びレチクルマーク RMB と基準マーク FMB との位置ずれ量を算出することにより、レチクル R の姿勢を検出する。主制御系 3 0 で求められたマーク相互の位置ずれ量データは、主制御系 3 0 からステージコントローラ 1 7 へと送られ、レチクル R とウエハ W とが正確に位置合わせされるように、レチクル R (及び / 又はウエハ W) の位置及び姿勢が調整される。

【 0 0 5 2 】

次に、この露光装置の動作について詳細に説明する。まず、この露光装置は、レチクルRがレチクルステージ11上に吸着保持された状態で、主制御系30がステージコントローラ17を制御してレチクルステージ11の加速度を段階的に増大又は減少させつつ、レチクルアライメント顕微鏡43A、43BによるレチクルRの姿勢の検出を繰り返し行うことにより、レチクルステージ11を加速又は減速させたときにレチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲を試行錯誤的に導出している。但し、レチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲を理論的計算（シミュレーション）により導出するようにしてもよい。

【0053】

図4は、レチクルステージ11を加速させたときにレチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲を求める処理の一例を示すフローチャートである。図4においては、加速度を段階的に増大させつつレチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲を求める処理の例について図示している。処理が開始すると、まず、主制御系30はレチクルステージ11の加速度を初期値に設定する処理を行う（ステップS10）。

【0054】

ここでは、加速度を段階的に増大させる場合を例に挙げて説明するため、加速度の初期値は低い値（この値は、例えばレチクルステージ11の真空吸着力及び過去の露光装置の運用の経験からレチクルRの位置ずれが生じない値が用いられる）に設定される。次に、基準マーク板40に形成された基準マークFMA、FMBを用いてレチクルRの位置合わせが行われる（ステップS11）。この処理は、例えば、レチクルアライメント顕微鏡43A、43BによってレチクルマークRMA、RMBとウエハステージ21上の基準マーク板40に形成されている基準マークFMA、FMBとを同時に観察することで、基準マークFMA、FMBとレチクルマークRMA、RMBとの位置合わせを行う。このとき、必要であればレチクルステージ駆動部18を介して、レチクルステージ11のXY平面内における回転角を調整する。

【0055】

レチクルRの位置合わせが終了すると、主制御系30はステージコントローラ

17に制御信号を出力し、レチクルステージ11の加速を開始する（ステップS12）。このとき、ステップS10で設定した加速度が制御信号の1つとして主制御系30からステージコントローラ17へ出力される。ステージコントローラ17は主制御系30から出力された加速度に基づいた推力がレチクルステージ11に与えられるよう、レチクルステージ駆動部18を制御する。

【0056】

レチクルステージ11を加速させた後、主制御系30はレチクルステージ11を低速で初期位置まで戻し、レチクルアライメント顕微鏡43A、43Bを用いてレチクルRの位置ずれを検出し（ステップS13）、その検出結果を位置ずれの有無を示す情報及び検出回数を示す情報とともに記憶装置31に記憶する（ステップS14）。以上の処理が終了すると、ユーザから検出終了指示がなされているか否かを判断する（ステップS15）。検出終了指示がなされている場合には処理を終了する。

【0057】

一方、ユーザから検出終了指示がなされていない場合（ステップS15の判断結果が「NO」の場合）には、ステップS13における検出結果に基づいて、レチクルRの位置ずれが有るか否かが判断される（ステップS16）。位置ずれが生じていないと判断された場合（ステップS16の判断結果が「NO」の場合）には、主制御系30は加速度をより高い値に設定し（ステップS17）、ステップS12に戻り、新たに設定した加速度でレチクルステージ11を加速させて、レチクルRの位置ずれを検出する。一方、ステップS16において、レチクルの位置ずれが有ると判断された場合（判断結果が「YES」の場合）には、主制御系30は加速度を低い値に設定し（ステップS18）、ステップS11に戻ってレチクルRの位置合わせを行って、新たに設定した加速度でレチクルステージ11を加速させて、レチクルRの位置ずれを検出する。

【0058】

以上、図4を参照して加速度を段階的に増大させつつレチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲を求める処理の例について説明したが、主制御系30は、以上説明した処理及びレチクルステージ11を減速させたときのレチクルRの位

位置ずれを検出する処理を繰り返し行い、加速度の大きさとレチクルRの位置ずれが生ずる頻度を統計的に求める。図5は、図4に示す処理等を行って得られた加速度の大きさとレチクルRの位置ずれが生ずる頻度との関係の一例を示す図である。

【 0 0 5 9 】

図5を参照すると、加速度が大きくなるにつれレチクルRの位置ずれが生ずる頻度が高くなるが、加速度が α_1 以下である場合にはレチクルRの位置ずれは全く生じなく、加速度が α_1 よりも大であって α_2 以下である場合には、位置ずれが生ずる頻度は低い、位置ずれが生ずる可能性があり、加速度が α_2 より大である場合には、殆ど位置ずれが生ずる。加速度が α_1 以下の範囲RE1は、レチクルステージ11を移動させたときにレチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲であり、加速度が α_1 よりも大であって α_2 以下である範囲RE2は、位置ずれか生ずる可能性のある加速度の範囲であり、加速度が α_2 より大である範囲RE3は、位置ずれが生ずる加速度の範囲である。主制御系30は、図4に示した処理を繰り返し行うことによって得られた検出結果に基づいてこれらの範囲を求め、記憶装置31に記憶する。

【 0 0 6 0 】

以上、レチクルステージ11を加速させたときにレチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲を求める処理の一例について説明したが、レチクルステージ11を減速させたときにレチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲を求める場合にも同様の処理を行って試行錯誤的に導出される。このとき、レチクルステージの移動方向（例えば正方向と負方向）に応じてそれぞれ加速度の範囲を求めてもよい。また、環境変化あるいは経時変化などに起因してレチクルステージによるレチクルの保持力（吸着能力）が変動し得るので、例えば環境条件が所定値を越えて変化するとき、あるいは所定時間毎に加速度の範囲を求めるようにしてもよい。なお、レチクルを静電吸着する場合、特に湿度に応じて吸着能力が変化する。さらに、その吸着能力を検出するセンサ（本例ではレチクルを真空吸着するので、一例として真空センサ）を設け、この検出される吸着能力に応じて先に導出した加速度の範囲を変更（補正）するようにしてもよい。以上説明した加速度

の範囲を導出する処理は、露光装置の起動時及びレチクルRの交換時の少なくとも一方において実施される。

【 0 0 6 1 】

次に、露光時の一連の動作について説明する。

【 0 0 6 2 】

〔第1動作例〕

図6は、本発明の実施形態に係る露光装置の第1動作例を示すフローチャートである。なお、図6は説明の簡単化のために1種類のレチクルを用いてウエハを露光処理する際のフローを例示している。

【 0 0 6 3 】

図6において、まずレチクルRをレチクルステージ11上に搬入してレチクルRを吸着保持する（ステップS20）。次に、レチクルアライメント顕微鏡43A、43BによってレチクルマークRMA、RMBとウエハステージ21上の基準マーク板40に形成されている基準マークFMA、FMBとを同時に観察することで、レチクルステージ11とウエハステージ21との相対位置調整を行う。そして、ウエハステージ21を移動した後、ウエハアライメント顕微鏡42で基準マーク板40に形成された基準マーク41を観察することで、レチクルRの基準位置（例えば、レチクルRの中心）とウエハアライメント顕微鏡42の基準位置（例えば、指標の中心）との距離（ベースライン量）を求める。

【 0 0 6 4 】

以上の処理を終了した後、ウエハステージ21上にウエハWを搬入し（ステップS21）、ウエハアライメント顕微鏡42を用いてウエハマークWMを計測することによりウエハWの位置情報を計測する。計測されたウエハWの位置情報を上記のベースライン量で補正し、レチクルRとウエハWとの相対位置を調整する（ステップS22）。レチクルRとウエハWとの相対位置が調整されると、主制御系30は記憶装置31に記憶されているレチクルステージ11を移動させたときにレチクルRの位置ずれが生じない加速度の範囲RE1（図5参照）を読み出し、レチクルステージ11を+Y軸方向へ移動させ、加速度がこの値以上とならないようにステージコントローラ17を介してレチクルステージ11を加速させ

る（ステップ S 2 3）とともに、ウエハステージ 2 1 を - Y 軸方向へ加速させる。

【 0 0 6 5 】

その後、レチクルステージ 1 1 とウエハステージ 2 1 とを同期走査しつつ、パルス照明光 I L をレチクル R に照射して得られるパターンの像を、投影光学系 P L を介してウエハ W 上に転写する（ステップ S 2 4）。レチクル R に形成されたパターン全ての像をウエハ W 上に転写し終わると、主制御系 3 0 は加速度がレチクル R の位置ずれが生じない加速度の範囲を越えないようにステージコントローラ 1 7 を介してレチクルステージ 1 1 を減速させる（ステップ S 2 5）とともに、ウエハステージ 2 1 を減速させて静止させる。なお、走査露光時のレチクルステージ 1 1 及びウエハステージ 2 1 の走査速度は予め決定されているので、その走査速度に達するまでの時間が最短となるように、加減速時の各加速度を対応する加速度の範囲を越えない最大値とすることが望ましい。

【 0 0 6 6 】

以上の処理が終了すると、露光処理を終えたウエハ W をウエハステージ W から搬出し（ステップ S 2 6）、露光処理を行う他のウエハの有無を判断する（ステップ S 2 7）。他のウエハがあると判断された場合には、ステップ S 2 1 へ戻り、他のウエハが無いと判断された場合には処理を終了する。

【 0 0 6 7 】

なお、図 6 に示したフローにおいて、複数種類のレチクルを用いてウエハの露光処理を行う場合には、ステップ S 2 5 の処理を終了した後、レチクルが交換されて新たなレチクルにてステップ S 2 2 ～ステップ S 2 5 で示される露光処理が行われ、かかる処理がレチクルの数に相当する回数行われ、ウエハ W 全面に対する露光処理を終えた後、ステップ S 2 6 にてウエハが搬出される。

【 0 0 6 8 】

〔第 2 動作例〕

図 7 は、本発明の実施形態に係る露光装置の第 2 動作例を示すフローチャートである。なお、図 7 に示した第 2 動作例も図 6 に示した第 1 動作例と同様に、説明の簡単化のために 1 種類のレチクルを用いてウエハを露光処理する際のフロー

を例示している。

【0069】

処理が開始すると、まず主制御系30は、記憶装置31に記憶されているレチクルRの位置ずれを生じさせない加速度の範囲の上限値（図5における加速度 α_1 ）をステージコントローラ17に閾値として出力する。そして、レチクルRをレチクルステージ11上に搬入してレチクルRを吸着保持し（ステップS30）、第1動作例と同様にレチクルステージ11とウエハステージ21との相対位置調整を行った後、ベースライン量を求める。次に、ウエハステージ21上にウエハWを搬入し（ステップS31）、ウエハアライメント顕微鏡42を用いてウエハWの位置情報を計測して計測値をベースライン量で補正し、レチクルRとウエハWとの相対位置を調整する（ステップS32）。

【0070】

以上の処理が終了すると露光処理が行われる（ステップS33）。この露光処理はレチクルステージ11及びウエハステージ21を加速して一定速度とした後、レチクルステージ11とウエハステージ21とを同期走査しつつ、照明光をレチクルRに照射して得られるパターンの像を、投影光学系PLを介してウエハW上に転写し、転写終了後、レチクルステージ11及びウエハステージ21を減速して静止させる処理である。

【0071】

ここで、ステージコントローラ17は露光処理中においてレチクルステージ11の加速時及び減速時における加速度を検出しており、検出した加速度が予め主制御系30から出力された閾値以上となった場合には、その旨を示す信号を主制御系30に出力する。露光処理が終了すると、ウエハステージ21上に載置されているウエハWが搬出される（ステップS34）。

【0072】

ウエハWの搬出が終了すると、主制御系30は露光処理中におけるレチクルステージ11の加速度が閾値を越えた旨を示す信号がステージコントローラ17から出力されているか否かを判断する（ステップS35）。出力されていない場合（ステップS35の判断結果が「NO」である場合）には、露光処理を行う他の

ウエハWの有無を判断し（ステップS 3 6）、ウエハWが有る場合にはステップS 3 1へ戻り、ウエハが無い場合には一連の露光処理が終了する。

【 0 0 7 3 】

一方、ステップS 3 5において、露光処理中におけるレチクルステージ1 1の加速度が閾値を越えた旨を示す信号がステージコントローラ1 7から出力されていると判断した場合（判断結果が「Y E S」の場合）には、ウエハステージ2 1とレチクルステージ1 1との相対位置が合う位置（ステップS 3 2において調整を行った位置）にウエハステージ2 1及びレチクルステージ1 1を移動させた後、レチクルアライメント顕微鏡4 3 A、4 3 BによってレチクルマークRMA、RMBとウエハステージ2 1上の基準マーク板4 0に形成されている基準マークFMA、FMBとを同時に観察してレチクルRの位置ずれ（X軸方向への位置ずれ、Y軸方向への位置ずれ、及びX Y面内における回転量）を計測する（ステップS 3 7）。

【 0 0 7 4 】

その後、レチクルRの位置ずれが生じているか否かを判断し（ステップS 3 8）、位置ずれがないと判断された場合には、前述したステップS 3 6へ進む。一方、ステップS 3 8において、位置ずれが生じていると判断された場合には、位置ずれが生じた旨をオペレータに通知する（ステップS 3 9）。この通知は、例えば露光装置3 5の処理状況を示すディスプレイ（図示省略）に位置ずれが生じた旨を示すメッセージを表示したり、警告音を発することにより行う。

【 0 0 7 5 】

次に、オペレータから露光処理を中止する指示がなされたか否かを判断し（ステップS 4 0）、中止指示がなされたと判断した場合には、一連の露光処理を終了する。一方、露光処理の中止指示がなされない場合には、主制御系3 0はステージコントローラ1 7を介して、ステップS 3 7で計測されたレチクルRの位置ずれを相殺するようにレチクルの姿勢を調整し（ステップS 4 1）、その後ステップS 3 6へ進む。このように、本実施形態においては、レチクルRの位置ずれが生じてもそのずれが自動的に修正されるので、一連の露光処理が中断される時間を最小限にできるため高スループットを図る上で好ましい。

【 0 0 7 6 】

なお、上述した第2動作例では、図7のステップS41において、ステップS37で計測されたレチクルRの位置ずれを相殺するようにレチクルRの姿勢を調整するようにしたが、レチクルステージ11とウエハステージ21との相対位置調整及びベースライン計測（ステップS30参照）を再実施するようにしてもよい。また、ステップS37で計測されたレチクルRの位置ずれに基づいて、ベースライン量を補正するようにしてもよい。

【 0 0 7 7 】

以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、本発明を限定するために記載されたものではない。従って、上記の実施形態に開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。

【 0 0 7 8 】

例えば、上記実施形態においては、ステージコントローラ17がレーザ干渉系16の計測結果に基づいてレチクルステージ11の加速度を検出する場合を例に挙げて説明したが、レチクルステージ11上に加速度センサを設ける構成としても良い。また、レチクルステージ11を駆動するリニアモータに対する推力指令値を用いて当該加速度を検出するようにしても良い。

【 0 0 7 9 】

また、上記実施形態においては、レチクルRはレチクルステージ11に真空吸着されるものと説明したが、レチクルRの吸着による撓み等を考慮して、より弱い吸着力でソフト吸着する場合や複数の支持ピン（例えば、3本）上に単に載置する無吸着の場合もある。このようなソフト吸着あるいは無吸着の場合には、レチクルRに位置ずれが生じ易くなるので、このような場合に本発明は特に有効である。

【 0 0 8 0 】

さらに、レチクルを真空吸着する代わりに、あるいは真空吸着と組み合わせて静電吸着を用いるようにしてもよい。また、前述の各実施形態では走査露光におけるレチクルステージ11の加減速時について説明したが、例えばレチクルRの

アライメント、アライメント系 4 2 のベースライン計測、及び投影光学系の結像特性の計測時などでレチクル R を移動する、アライメント位置と露光位置（加速開始位置）との間でレチクル R を移動する、あるいはレチクル R のパターンを複数回の露光に分けてウエハ上に転写するためにレチクル R を走査方向と直交する非走査方向にステッピングさせる場合などであっても、前述した実施形態と全く同様に加速度を設定してレチクルステージ 1 1 の移動を制御してもよい。また、姿勢検出装置はレチクルアライメント顕微鏡 4 3 A、4 3 B に限られるものではなく、例えば投影光学系 P L を介してレチクル R のパターン、アライメントマークなどを検出する光学系、あるいはレチクル R の端面を鏡面加工してレーザビームを照射する干渉計など、いかなる構成でもよい。

【 0 0 8 1 】

上記実施形態においては、レチクル R について本発明を適用した場合を説明しているが、基板について適用することも勿論可能である。特に、露光装置を用いてマスク（又はレチクル）を製造する場合の露光対象としての基板（ブランクス）は、支持に伴う撓み等を考慮して、上記レチクル R と同様に保持ないし支持される場合があり、このような場合に本発明を適用することは有効である。

【 0 0 8 2 】

上述した実施形態に係る露光装置（図 1）は、スループットを向上しつつ高い露光精度で露光が可能となるように、照明光学系、投影光学系 P L、駆動部 1 8 を含むレチクルステージ 1 1、駆動部 2 3 を含むウエハステージ 2 1、レーザ干渉系 1 6、2 2、レチクルアライメント系、ウエハアライメント系等の図 1 に示された各要素が電氣的、機械的、又は光学的に連結して組み上げられた後、総合調整（電気調整、動作確認等）をすることにより製造される。露光装置の製造は、温度及びクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。

【 0 0 8 3 】

本発明の実施形態に係る露光装置を用いてデバイス（I C や L S I 等の半導体チップ、液晶パネル、C C D、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等）を生産するには、まず、設計ステップにおいて、デバイスの機能設計（例えば、半導体デバイスの回路設計等）を行い、その機能を実現するためのパターン設計を行う。引

き続き、マスク製作ステップにおいて、設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。一方、ウエハ製造ステップにおいて、シリコン等の材料を用いてウエハを製造する。

【 0 0 8 4 】

次に、ウエハプロセスステップにおいて、上記ステップで用意したマスクとウエハを使用して、リソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路等を形成する。次いで、組立ステップにおいて、ウエハプロセスステップにおいて処理されたウエハを用いてチップ化する。この組立ステップには、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）、パッケージング工程（チップ封入）等の工程が含まれる。最後に、検査ステップにおいて、組立ステップで作製されたデバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経た後にデバイスが完成し、これが出荷される。

【 0 0 8 5 】

なお、上述した実施形態では、レチクルと基板とを同期移動してマスクのパターンを逐次転写する走査型の露光装置を一例として説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、順次ステップ移動させつつ、マスクと基板とを静止させた状態で一括露光する静止型の露光装置にも適用することができる。また、露光装置の用途としては半導体製造用の露光装置に限定されることなく、例えば、液晶表示素子やプラズマディスプレイ等を含むディスプレイ装置、薄膜磁気ヘッド、撮像素子（CCD）、マスク（レチクル）、DNAチップ、更には携帯電話や家庭用ゲーム機などで使用されるバイブレータ（振動子）等の製造に用いられる露光装置に対しても適用することができる。

【 0 0 8 6 】

本実施形態の露光装置の光源は、g線（436nm）、i線（365nm）、KrFエキシマレーザ（248nm）、ArFエキシマレーザ（193nm）、F₂レーザ（157nm）、Ar₂エキシマレーザ（波長126nm）のみならず、金属蒸気レーザ又はYAGレーザなどの高調波などを用いることができる。また、DFB半導体レーザ又はファイバーレーザから発振される赤外域、又は可視域の単一波長レーザを、例えばエルビウム（又はエルビウムとイットリビウム

の両方) がドーブされたファイバーアンプで増幅し、更に非線形光学結晶を用いて紫外光に波長変換した高調波を用いてもよい。

【 0 0 8 7 】

例えば、単一波長レーザの発振波長を $1.51 \sim 1.59 \mu\text{m}$ の範囲内とすると、発生波長が $189 \sim 199 \text{ nm}$ の範囲内である 8 倍高調波、又は発生波長が $151 \sim 159 \text{ nm}$ の範囲内である 10 倍高調波が出力される。特に発振波長を $1.544 \sim 1.553 \mu\text{m}$ の範囲内とすると、 $193 \sim 194 \text{ nm}$ の範囲内の 8 倍高調波、即ち Ar F エキシマレーザとほぼ同一波長となる紫外光が得られ、発振波長を $1.57 \sim 1.58 \mu\text{m}$ の範囲内とすると、 $157 \sim 158 \text{ nm}$ の範囲内の 10 倍高調波、即ち F_2 レーザとほぼ同一波長となる紫外光が得られる。

【 0 0 8 8 】

また、発振波長を $1.03 \sim 1.12 \mu\text{m}$ の範囲内とすると、発生波長が $147 \sim 160 \text{ nm}$ の範囲内である 7 倍高調波が出力され、特に発振波長を $1.099 \sim 1.106 \mu\text{m}$ の範囲内とすると、発生波長が $157 \sim 158 \mu\text{m}$ の範囲内の 7 倍高調波、即ち F_2 レーザとほぼ同一波長となる紫外光が得られる。なお、単一波長発振レーザとしてはイットリビウム・ドーブ・ファイバーレーザを用いる。

【 0 0 8 9 】

更に、照明光は前述の遠紫外域、又は真空紫外域 (波長 $120 \sim 200 \text{ nm}$) に限られるものではなく、レーザプラズマ光源、又は SOR から発生する軟 X 線領域 (波長 $5 \sim 15 \text{ nm}$ 程度)、例えば波長 13.4 nm 、又は 11.5 nm の EUV (Extreme Ultra Violet) 光であってもよいし、あるいは硬 X 線領域 (波長 1 nm 程度以下) であってもよい。なお、EUV 露光装置では反射型レチクル (マスク) が用いられるとともに、投影光学系は像面側のみがテレセントリックな縮小系であって、かつ複数枚 (3 ~ 6 枚程度) の反射光学素子のみからなる反射系である。

【 0 0 9 0 】

また、上述した実施形態では、投影光学系 PL は縮小系としたが、等倍系又は拡大系であってもよく、投影光学系 PL は複数の屈折素子のみからなる屈折系、

複数の反射素子のみからなる反射系、及び屈折素子と反射素子からなる反射屈折系のいずれであってもよい。

【0091】

ウエハステージやレチクルステージにリニアモータを用いる場合は、エアベアリングを用いたエア浮上型及びローレンツ力又はリアクタンス力を用いた磁気浮上型のどちらを用いてもよい。また、ステージは、ガイドに沿って移動するタイプでもよいし、ガイドを設けないガイドレスタイプでもよい。ステージの駆動装置としては、2次元に磁石を配置した磁石ユニットと、2次元にコイルを配置した電機子ユニットとを対向させ電磁力によりステージを駆動する平面モータを用いてもよい。

【0092】

ウエハステージの移動により発生する反力は、特開平8-166475号公報に記載されているように、フレーム部材を用いて機械的に床（大地）に逃がしてもよい。レチクルステージの移動により発生する反力は、特開平8-330224号公報に記載されているように、フレーム部材を用いて機械的に床（大地）に逃がしてもよい。

【0093】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、マスク又は基板の移動に伴う位置ずれを生じさせずに高スループットで露光できるようになり、マイクロデバイス等の生産性を向上することができるという効果がある。

【0094】

また、マスク又は基板の移動に伴う位置ずれが生じた場合であっても、これをオペレータに通知し、あるいは位置ずれを自動修復して露光処理を継続するようにしたので、位置ずれのある状態で露光処理が継続されることが防止され、不良品を生じさせることが少なくなるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態に係る露光装置の全体構成を示す図である。

【図2】 本発明の実施形態に係る露光装置が備えるアライメント系の概略

構成図である。

【図 3】 レチクルアライメントで検出されるレチクルマーク及び基準マークの像並びにその光電変換信号を示す図である。

【図 4】 レチクルステージを加速させたときにレチクルの位置ずれが生じない加速度の範囲を求める処理の一例を示すフローチャートである。

【図 5】 図 4 に示す処理等を行って得られた加速度の大きさとレチクルの位置ずれが生ずる頻度との関係の一例を示す図である。

【図 6】 本発明の実施形態に係る露光装置の第 1 動作例を示すフローチャートである。

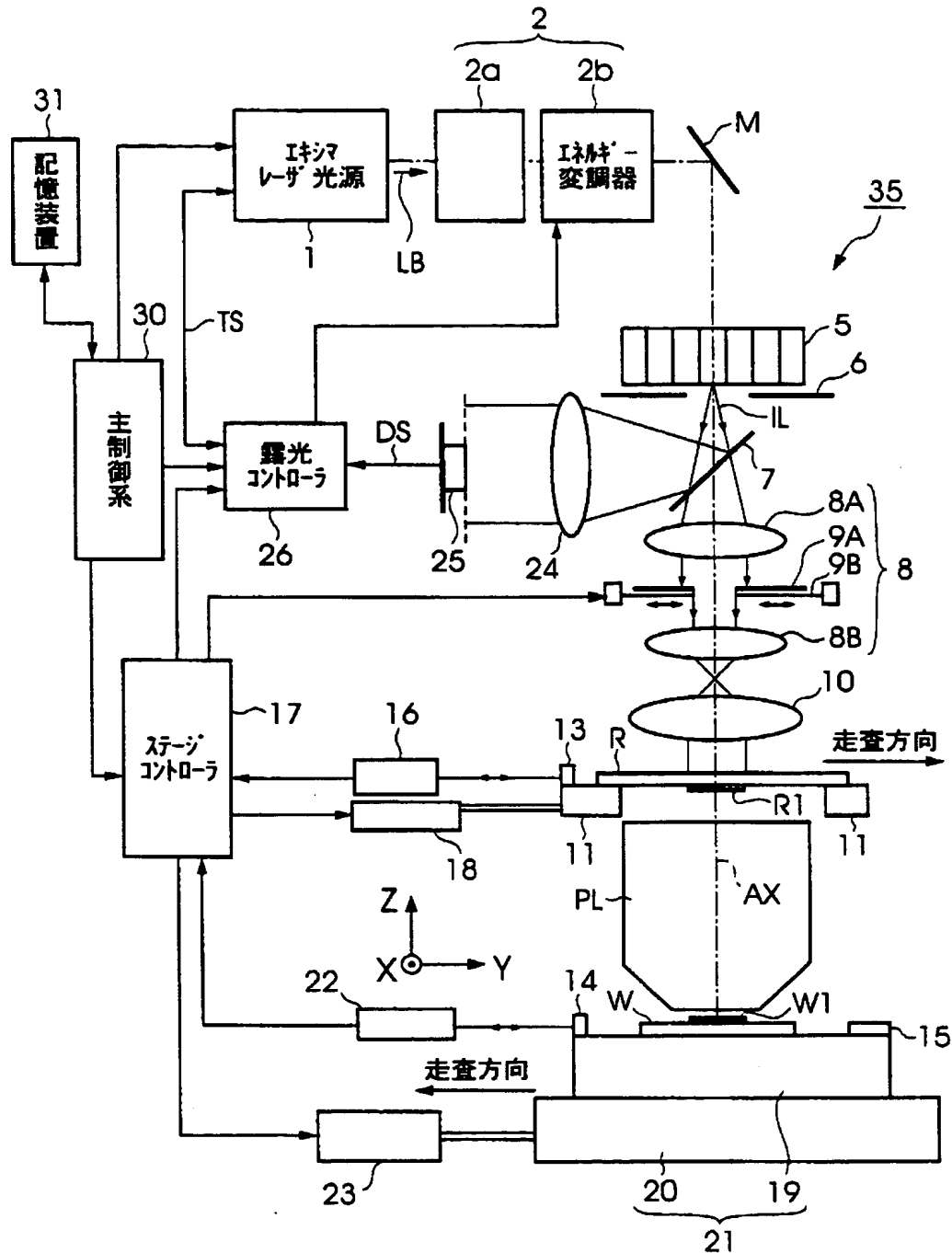
【図 7】 本発明の実施形態に係る露光装置の第 2 動作例を示すフローチャートである。

【符号の説明】

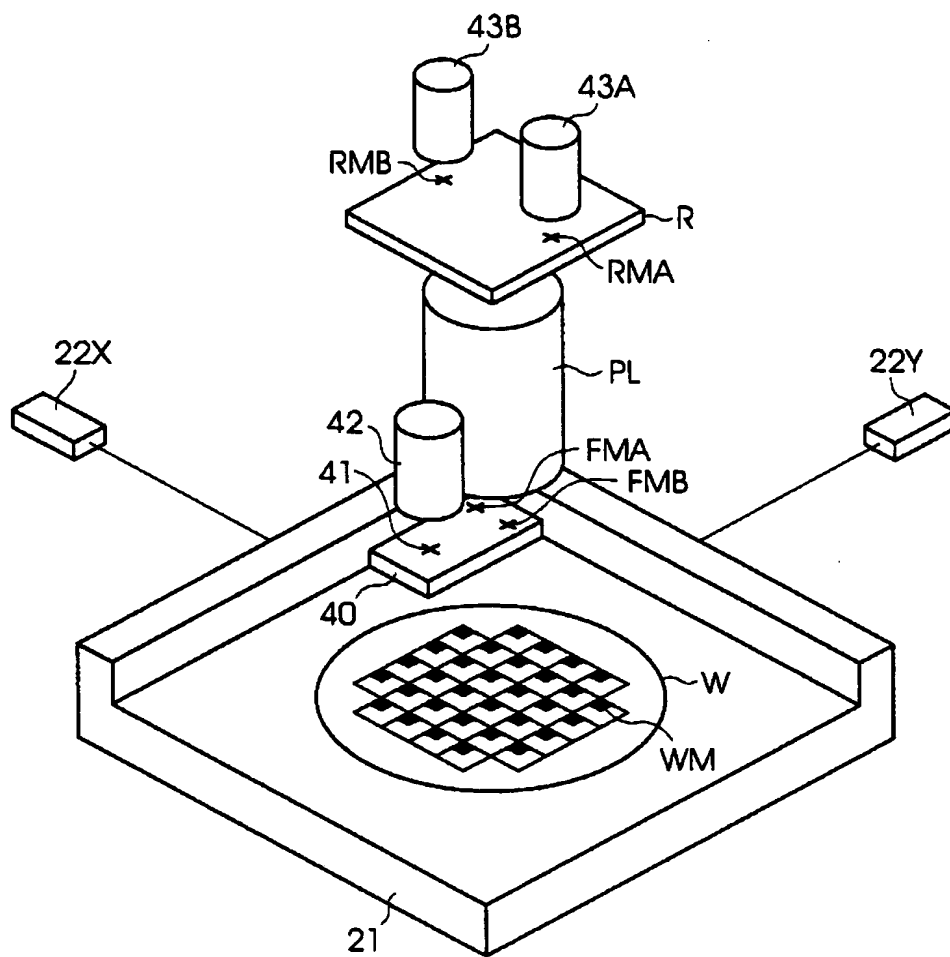
- 1 1 …レチクルステージ（ステージ）
- 1 7 …ステージコントローラ（加速度検出装置）
- 1 8 …レチクルステージ駆動部（姿勢調整装置）
- 3 0 …主制御系（制御装置）
- 3 5 …露光装置
- 4 3 A, 4 3 B …レチクルアライメント顕微鏡（姿勢検出装置）
- R …レチクル（マスク）
- W …ウエハ（基板）

【書類名】 図面

【図 1】

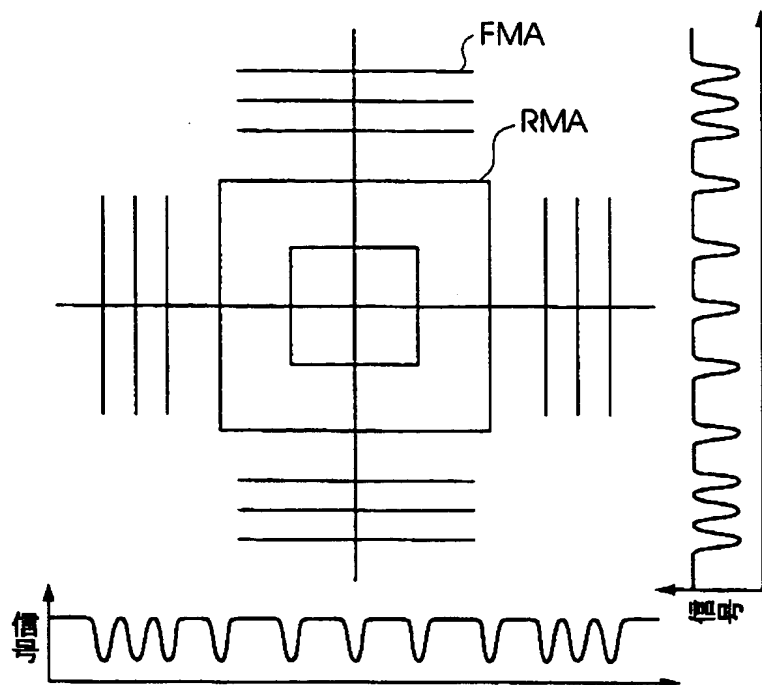


【図 2】

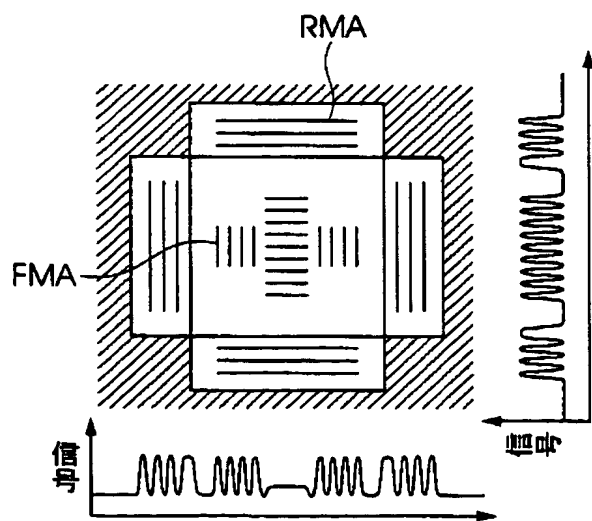


【图 3】

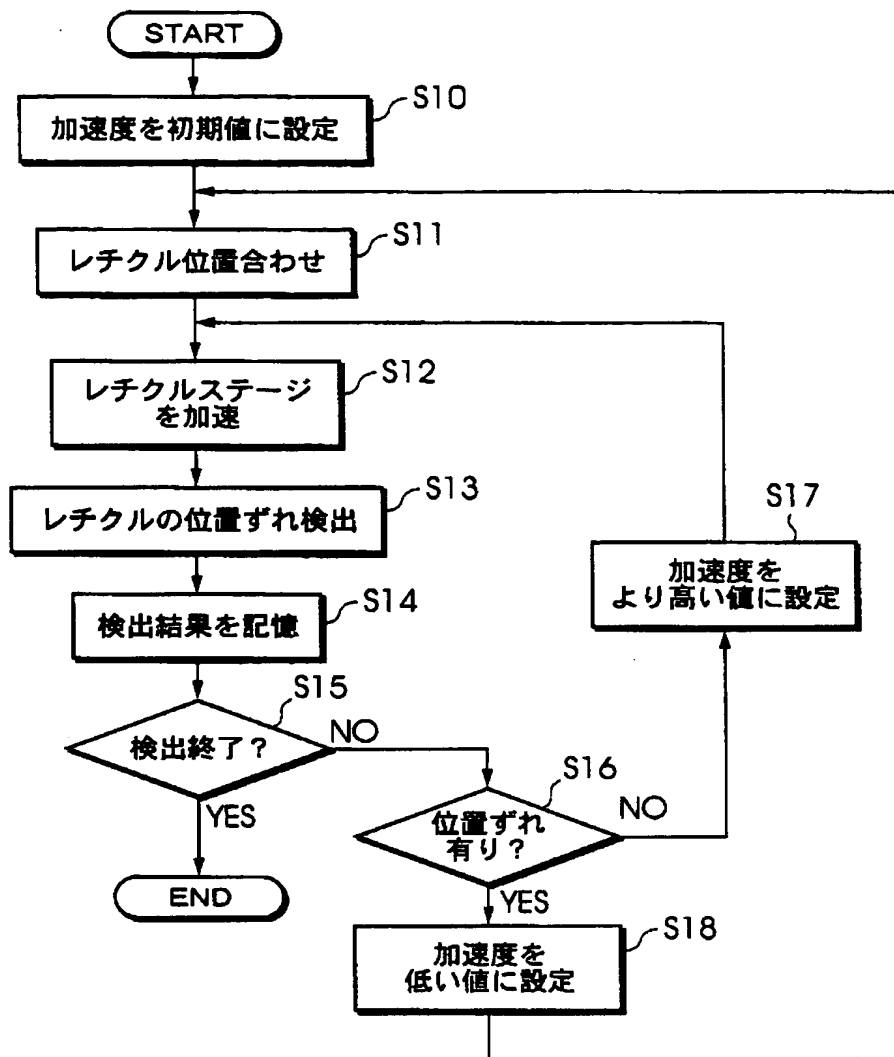
(a)



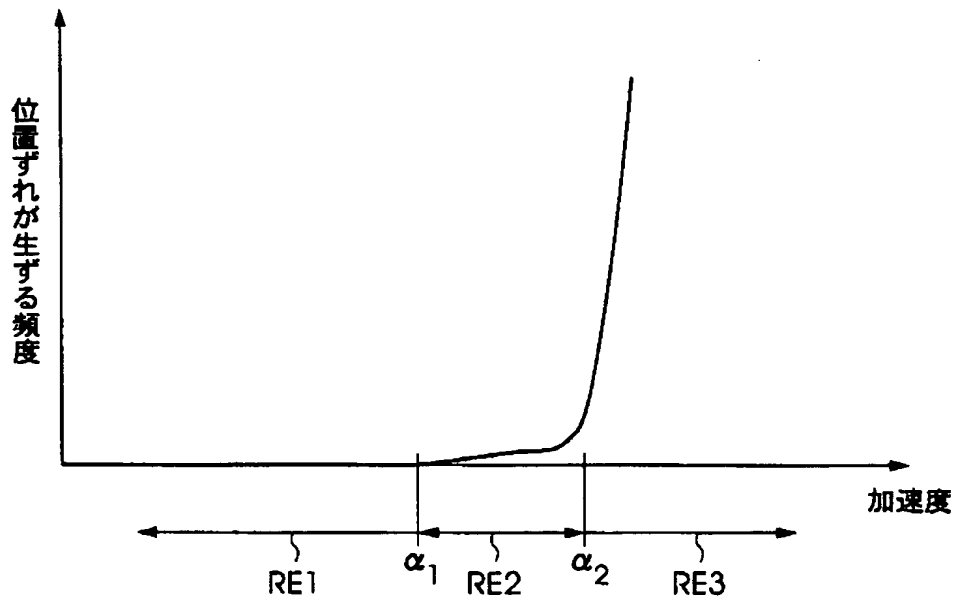
(b)



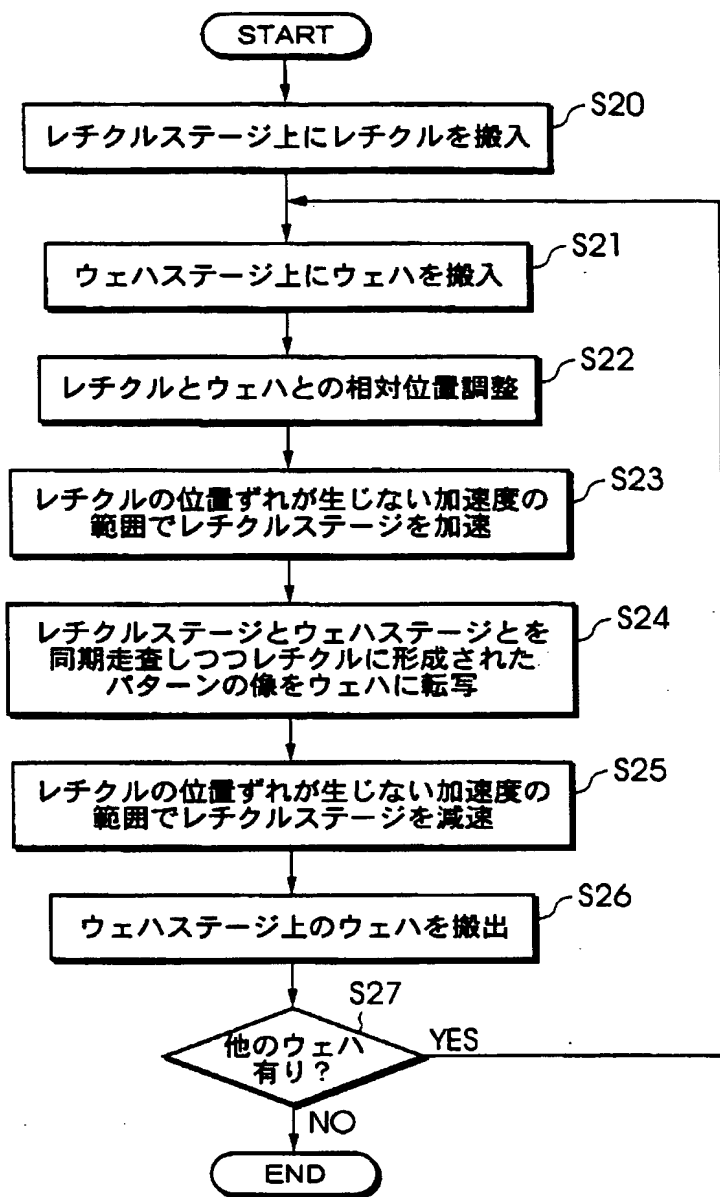
【図 4】



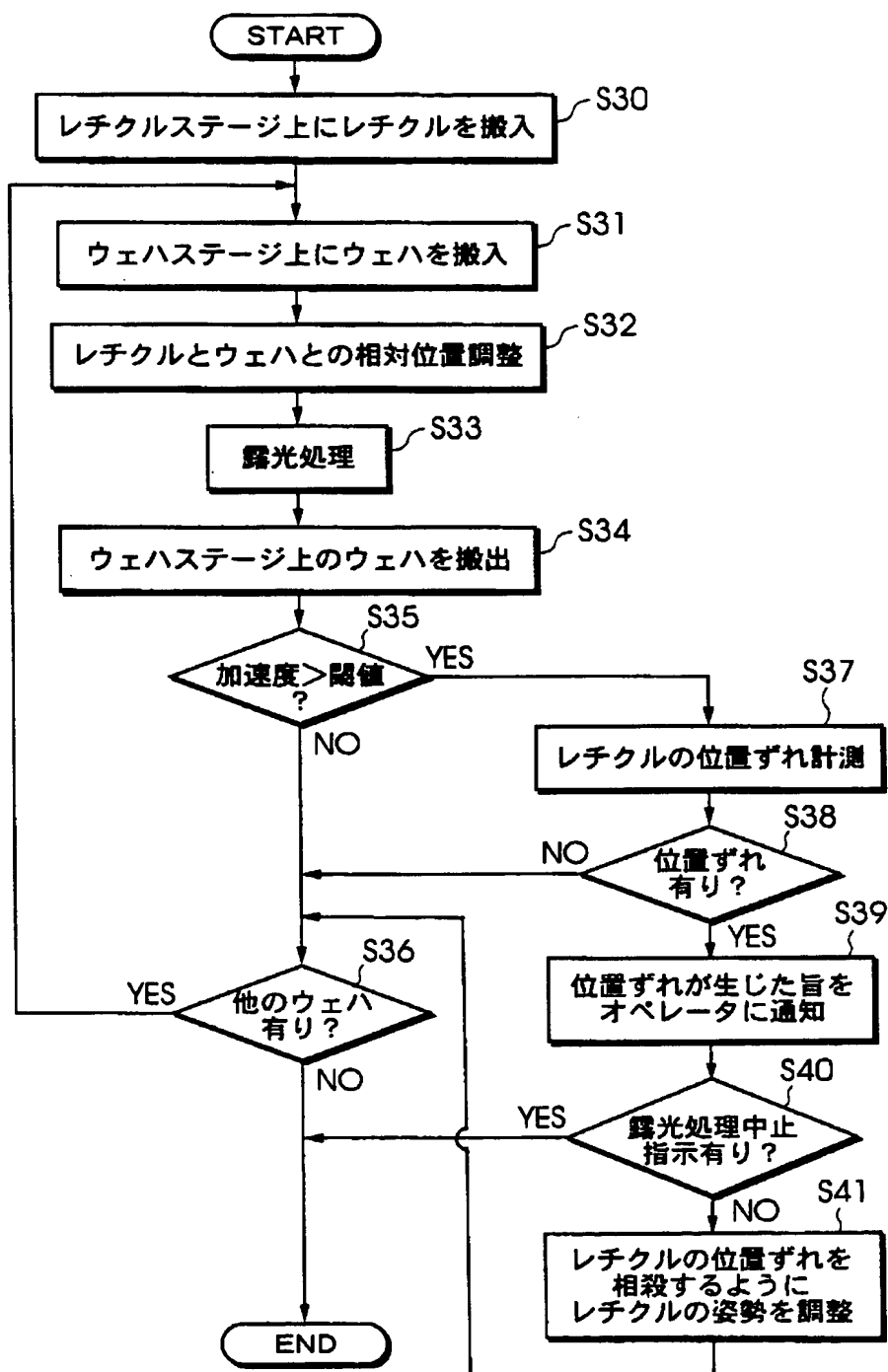
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 マスクの移動に伴う位置ずれを生じさせずに高スループットで露光する。

【解決手段】 レチクルステージ 1 1 はレチクル R を保持して移動し、ステージコントローラ 1 7 はレーザ干渉系 1 6 の検出結果に基づいてレチクルステージ 1 1 の加速度を検出する。主制御系 3 0 はレチクルステージ 1 1 によって検出される加速度が予め求められたレチクル R に位置ずれが生じないレチクルステージ 1 1 の加速度の範囲内となるようにレチクルステージ 1 1 の移動を制御し、レチクル R とウエハ W とを同期移動しつつレチクル R に形成されたパターンの像を、投影光学系 P L を介してウエハ W に転写する。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2000-390183
受付番号	50001658211
書類名	特許願
担当官	小菅 博 2143
作成日	平成 12 年 12 月 27 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000004112
【住所又は居所】	東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
【氏名又は名称】	株式会社ニコン

【代理人】

申請人

【識別番号】	100097180
【住所又は居所】	東京都千代田区猿楽町 2 丁目 1 番 1 号 桐山ビル 前田・西出国際特許事務所
【氏名又は名称】	前田 均

【代理人】

【識別番号】	100099900
【住所又は居所】	東京都千代田区猿楽町 2 丁目 1 番 1 号 桐山ビル 前田・西出国際特許事務所
【氏名又は名称】	西出 眞吾

【選任した代理人】

【識別番号】	100111419
【住所又は居所】	東京都千代田区猿楽町 2 丁目 1 番 1 号 桐山ビル 前田・西出国際特許事務所
【氏名又は名称】	大倉 宏一郎

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004112]

1. 変更年月日 1990年 8月29日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
氏 名 株式会社ニコン